



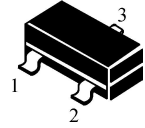
安徽富信半導體科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO., LTD

MMBTA44

SOT-23

- 1. BASE
- 2. EMITTER
- 3. COLLECTOR



■ MAXIMUM RATINGS 最大額定值

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Rating 額定值	Unit 單位
Collector-Emitter Voltage 集電極-射極電壓	V_{CEO}	400	V
Collector-Base Voltage 集電極-極電壓	V_{CBO}	400	V
Emitter-Base Voltage 發射極-基極電壓	V_{EBO}	7	V
Collector Current 集電極電流	I_C	200	mA
Device Dissipation 耗散功率	P_D	225	mW
Junction and Storage Temperature 結溫 and 儲存溫度	T_J, T_{stg}	-55to+125	°C

■ ELECTRICAL CHARACTERISTICS 電特性

($T_A=25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted 如無特殊說明, 溫度為 25°C)

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Min 最小值	Max 最大值	Unit 單位
Collector-Emitter Breakdown Voltage 集電極-射極擊穿電壓($I_C=1\text{mA}, I_B=0$)	$V_{(BR)CEO}$	400	—	V
Collector-Base Breakdown Voltage 集電極-基極擊穿電壓($I_C=100\mu\text{A}, I_E=0$)	$V_{(BR)CBO}$	400	—	V
Emitter-Base Breakdown Voltage 發射極-基極擊穿電壓($I_E=100\mu\text{A}, I_C=0$)	$V_{(BR)EBO}$	7	—	V
Collector Cutoff Current 集電極截止電流 ($V_{CB}=300\text{V}, I_E=0$)	I_{CBO}	—	500	nA
DC Current Gain 直流電流增益 ($I_C=10\text{mA}, V_{CE}=10.0\text{V}$)	H_{FE}	40	300	—
Collector-Emitter Saturation Voltage 集電極-發射極飽和壓降 ($I_C=100\text{mA}, I_B=10\text{mA}$)	$V_{CE(sat)}$	—	0.5	V
Current-Gain-Bandwidth Product 電流增益帶寬乘積 ($I_C=10\text{mA}, V_{CE}=20\text{V}, f=30\text{MHz}$)	f_T	50	—	MHz

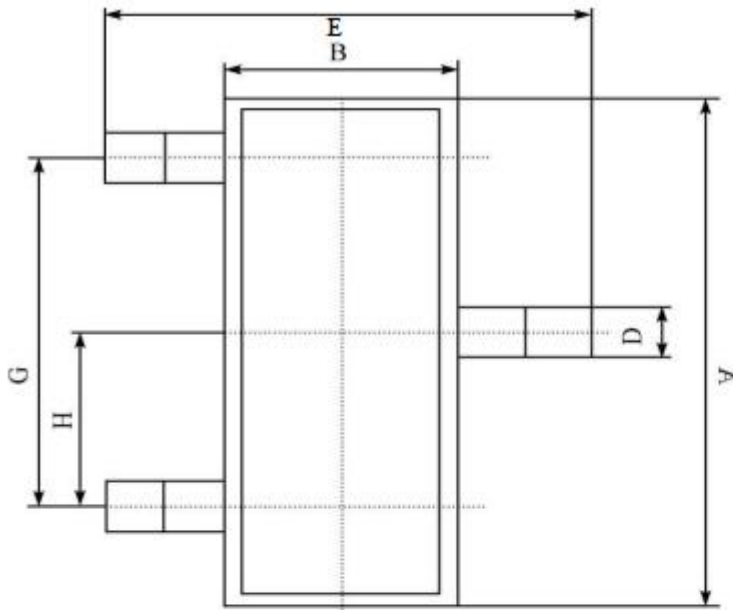
■ DEVICE MARKING 打標

MMBTA44=3D

MMBTA44

■ DIMENSION 外形封裝尺寸

單位(UNIT): mm



代碼	範圍(單位:mm)
A	2.80~3.00
B	1.20~1.40
C	0.90~1.10
D	0.30~0.50
E	2.20~2.60
G	1.80~2.00
H	0.90~1.00
J	0.08~0.18
K	0.02~0.12
M	≥0.22
N	0.50~0.70
P	6°~10°

